







	<h2>SI3443BDV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3443BDV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3443BDV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 34053 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3443BDV-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	34053 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3.6A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.1W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI3443BDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3443BDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3443BDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3443BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3443CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p>SI3443BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3443BDV-T1 Vishay Vishay SOT23-6</p>
 <p>SI3443BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3443CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p>SI3443BVD VISHAY SI3443BVD VISHAY</p>	 <p>SI3443BDV Vishay Precision Group SI3443BDV VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

<ul style="list-style-type: none"> ⊕ SI3441BDV-T1-E3 ⊖ SI3441DV-T1 ⊕ SI3442BDV-T1-E3 D SI3442CDV-T1-GE3 ⇒ SI3442DV-T1-GE3 ↔ SI3443BDV-T1-GE3 ⊕ SI3443CDV-T1-GE3 ⊖ SI3443DV ⊕ SI3443DVTR ↔ SI3445ADV-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ↔ SI3441BDV-T1-GE3 ⊕ SI3441DV-T1-E3 ⊖ SI3442BDV-T1-E3 ⊕ SI3442DV ↔ SI3443ADV-T1-E3 ⇒ SI3443BVD D SI3443DDV-T1-GE3 ⊕ SI3443DV-NL ⊖ SI3443DVTRPBF ⊕ SI3445ADV-T1-GE3 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI3441BDV-T1-GE3 D SI3441DV-T2 ⊕ SI3442BDV-T1-GE3 ⊖ SI3442DV ⊕ SI3443BDV D SI3443CDV-T1-E3 ⇒ SI3443DDV-T1-GE3 ↔ SI3443DV-T1 ⊕ SI3445ADV-T1 ⊖ SI3445BDV 	<ul style="list-style-type: none"> D SI3441DV ⇒ SI3441DV-T1-E3 ↔ SI3442BDV-T1-GE3 ⊕ SI3442DV-T1 ⊖ SI3443BDV-T1-E3 ⊕ SI3443CDV-T1-E3 ↔ SI3443DV ⇒ SI3443DV-T1-E3 D SI3445ADV-T1-E3 ⊕ SI3445DV 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ SI3441DV-NL ⇒ SI3442BDV ⇒ SI3442CDV-T1-GE3 ⇒ SI3442DV-T1-E3 ⇒ SI3443BDV-T1-E3 ⊖ SI3443CDV-T1-GE3 ⇒ SI3443DV ⇒ SI3443DV-T1-GE3 ⇒ SI3445ADV-T1-E3 ⇒ SI3445DV-T1
--	---	---	--	--

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited